

トランジスタ

2SD836, 2SD836A

# 2SD836, 2SD836A

シリコン NPN 三重拡散プレーナ形ダーリントン / Si NPN Triple Diffused Planar Darlington

低周波電力増幅 / AF Power Amplifier

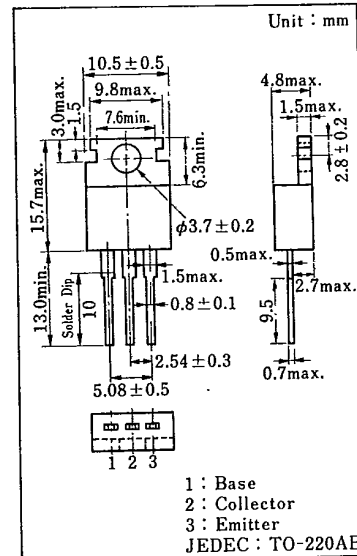
2SB750, 2SB750A とコンプリメンタリ / Complementary Pair with 2SB750, 2SB750A

■ 特徴 / Features

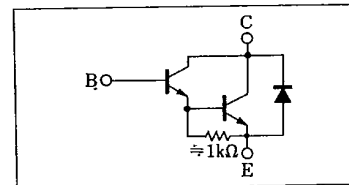
- 直流電流増幅率  $h_{FE}$  が高い。 / High  $h_{FE}$
- スイッチング速度が速い。 / High Speed switching

■ 絶対最大定格 / Absolute Maximum Rating ( $T_a = 25^\circ C$ )

Item	Symbol	Value	Unit
コレクタ・ベース電圧	2SD836	60	V
	2SD836A	80	
コレクタ・エミッタ電圧	2SD836	60	V
	2SD836A	80	
エミッタ・ベース電圧	$V_{EBO}$	5	V
せん頭コレクタ電流	$I_{CP}$	4	A
コレクタ電流	$I_C$	2	A
コレクタ損失 ( $T_c = 25^\circ C$ )	$P_C$	35	W
接合部温度	$T_J$	150	$^\circ C$
保存温度	$T_{stg}$	-55 ~ +150	$^\circ C$



内部接続図 / Connection Diagram



■ 電気的特性 / Electrical Characteristics ( $T_a = 25^\circ C$ )

Item	Symbol	Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ シャ断電流	2SD836	$V_{CB} = 60 V, I_E = 0$			1	mA
	2SD836A				1	
コレクタ シャ断電流	2SD836	$V_{CE} = 30 V, I_B = 0$			2	mA
	2SD836A				2	
エミッタシャ断電流	$I_{EBO}$	$V_{EB} = 5 V, I_C = 0$			2	mA
コレクタ・ エミッタ電圧	2SD836	$I_C = 30 mA, I_B = 0$	60			V
	2SD836A		80			
直流電流増幅率		$h_{FE1}$	$V_{CE} = 4 V, I_C = 1 A$	1000		
		$h_{FE2}^*$	$V_{CE} = 4 V, I_C = 2 A$	1000	10000	
ベース・エミッタ電圧	$V_{BE}$	$V_{CE} = 4 V, I_C = 2 A$			2.8	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(sat)}$	$I_C = 2 A, I_B = 8 mA$			2.5	V
ターンオン時間	$t_{on}$	$I_C = 2 A, I_{B1} = -I_{B2} = 8 mA$		0.4		$\mu s$
ターンオフ時間	$t_{off}$			4		$\mu s$

\*  $h_{FE2}$  ランク分類 /  $h_{FE2}$  Classifications

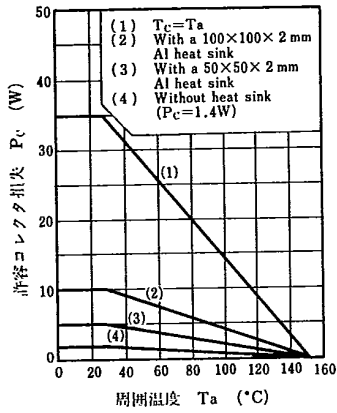
Class	R	Q	P
$h_{FE2}$	1000 ~ 2500	2000 ~ 5000	4000 ~ 10000

トランジスタ

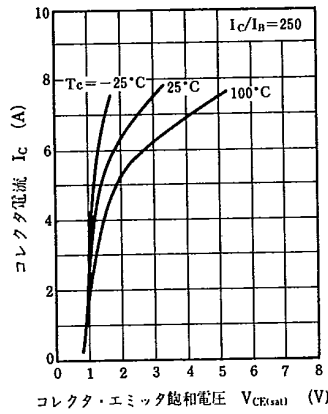
T-33-29

2SD836, 2SD836A

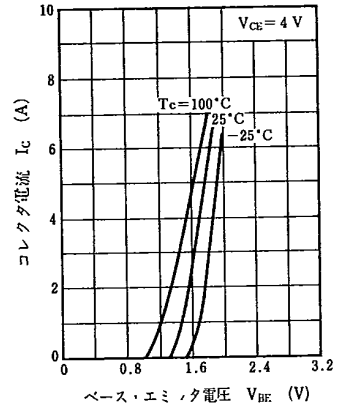
$P_C - T_a$



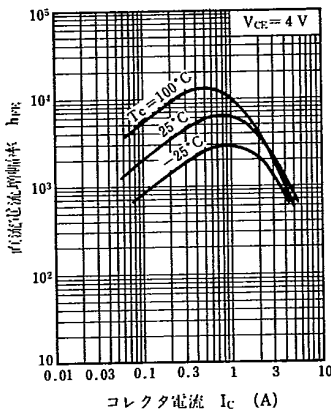
$I_C - V_{CE(sat)}$



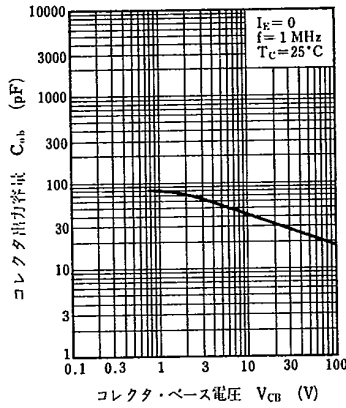
$I_C - V_{BE}$



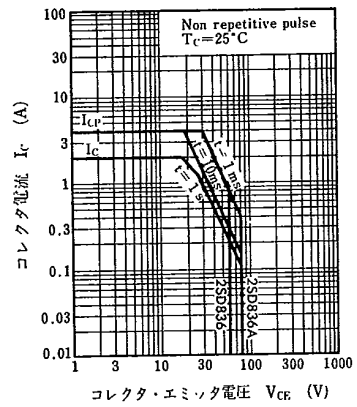
$h_{FE} - I_C$



$C_{ob} - V_{CB}$



安全動作領域 ASO



$R_{th(t)} - t$

